

**Фізичні основи радіаційно - термічної технології підвищення  
радіаційної стійкості напівпровідників на прикладі  
перспективного матеріалу  $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ .**

*Литовченко П.Г., Барабаш Л.І., Варенцов М.Д., Гайдар Г.П., Гроза А.А.,  
Долголенко А.П., Дубовий В.К., Карпенко А.Я., Кібкало Т.І., Кочкін В.І.,  
Ластовецький В.Ф., Полівцев Л. А., Старчик М.І.*

Відділ радіаційної фізики Інституту Ядерних Досліджень НАН України  
e-mail: [ayak@kinr.kiev.ua](mailto:ayak@kinr.kiev.ua)

На основі численних даних досліджень електрофізичних, структурних властивостей перспективного напівпровідникового матеріалу  $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$  обґрунтовується концепція підвищення радіаційної стійкості напівпровідників та приладів на їх основі.